

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт природно-технических систем» (ИПТС)

для проведения аттестации

Сычева Евгения Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

на соответствие занимаемой должности _____

ведущего научного сотрудника

(наименование должности)

1. Сведения об образовании _____

1965 – 1971 гг. – очное обучение в Московском энергетическом институте (МЭИ). Выдан диплом с отличием Ш № 621571 по специальности «Тепловые электрические станции», квалификация «Инженер-теплоэнергетик».

1973 – 1976 гг. – обучение в очной аспирантуре МЭИ. В 1977 г. защита диссертации по специальности «Теплофизика», присвоена ученая степень Кандидата технических наук (Диплом ТН № 016694).

2000 г. – научно-педагогическая стажировка в США, университет штата Орегон (02.05.2000), университет штата Айдахо (05.06.2000). Выдан: «Certificate of Completion. This is to certify that EVGENIY SYCHOV has successfully completed Contemporary Issues Fellowship Program, a program sponsored by Bureau of Educational and Cultural Affairs, US Department of State and administered by the International Research & Exchanges Board for a period of four months from February – June 2000»

2002 г. – присвоено ученое звание «Доцент» (Аттестат доцента ДЦ № 004088)

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж 51 лет, научно-педагогический стаж 46 лет, в том числе стаж работы в должности 2 лет.

3. Сведения о научно-исследовательской деятельности: работал на различных научных и педагогических должностях в НИИ АН СССР, АН УССР и НАН Украины, в ВУЗ'ах Москвы, Могилева (БССР) и Севастополя,

имеет 117 публикаций научно-исследовательского и учебно-методического характера, статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, доклады на конференциях, учебники для ВУЗ, учебно-методические пособия.

За период с 2015 по 2017 гг. опубликовано статей – 4, участие в конференциях – 3.

(публикации в научных сборниках, периодических научных изданиях, в материалах научных мероприятий, в зарегистрированных научных изданиях; изданные монографии и главы в монографиях, статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, научно-популярные книги и статьи; участие в выполнении грантов и договоров на научно-исследовательские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием конкретной роли; участие в научных мероприятиях с указанием статуса доклада и уровня мероприятия; участие в редакционных комиссиях научно-педагогических периодических изданий и пр.)

4. Сведения о наградах и поощрениях _____

Медаль «За возвращение Крыма» Министерства обороны Российской Федерации.

Медаль «Россия – Крым – Севастополь» Губернатора г. Севастополя.

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института

Участие в международных научно-технических конференциях

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности
Профессионализм, самостоятельность, трудолюбие

8. Замечания
нет

9. Мнение заведующего лабораторией о соответствии занимаемой должности
Сычев Евгений Николаевич должности ведущего научного сотрудника соответствует

Заведующий лабораторией систем
глубоководных исследований

наименование

личная подпись

А.Н. Греков

расшифровка

« ____ » _____ 20__ года

Я, _____ Сычев Евгений Николаевич _____ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку своих персональных данных (Ф.И.О., должность, сведения об образовании, сведения об общем трудовом стаже, сведения о научной деятельности, сведения о наградах и поощрениях), включая сбор, хранение, обработку, использование, распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных, в том числе в сети Интернет.

личная подпись

Е.Н. Сычев

расшифровка

С представлением ознакомлен
ведущий научный сотрудник

наименование должности работника

личная подпись

Е.Н. Сычев

расшифровка

« ____ » _____ 20__ года